

Docket No.: MAS-FIN-406

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : ROBERT-CHRISTIAN HAGEN ET AL.
Filed : CONCURRENTLY HEREWITH
Title : ELECTRONIC COMPONENT WITH A STACK OF
SEMICONDUCTOR CHIPS AND A METHOD FOR PRODUCING
THE ELECTRONIC COMPONENT

CLAIM FOR PRIORITY

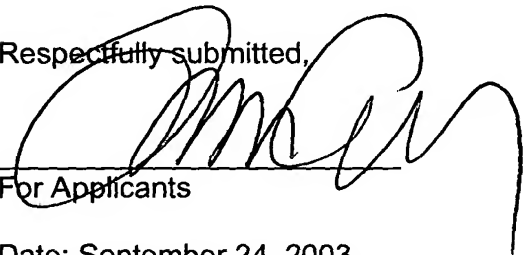
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119,
based upon the German Patent Application 102 44 664.4, filed September 24, 2002.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted
herewith.

Respectfully submitted,


For Applicants

LAURENCE A. GREENBERG
REG. NO. 29,308

Date: September 24, 2003

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100
Fax: (954) 925-1101

/kf



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 44 664.4

Anmeldetag: 24. September 2002

Anmelder/Inhaber: Infineon Technologies AG,
München/DE

Bezeichnung: Elektronisches Bauteil mit Halbleiterchips in
einem Stapel und Verfahren zur Herstellung
desselben

IPC: H 01 L 21/98

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 28. August 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Stempel

FIN 406 P/200211221

1



Beschreibung

Elektronisches Bauteil mit Halbleiterchips in einem Stapel und Verfahren zur Herstellung desselben.

5

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit Halbleiterchips in einem Stapel und ein Verfahren zu Herstellung desselben. Insbesondere betrifft die Erfindung ein elektronisches Bauteil mit einem Stapel aus einem Logikchip in Flipchip-Technologie und einem funktionsgetesteten Speicherbaustein in Bondtechnologie.

Das Bestreben immer höhere Schaltdichten zu erreichen, führt zu größerer Systemintegration, wobei zunehmend versucht wird, mehrere Halbleiterchips in einem Stapel anzuordnen. Dabei muß häufig ein komplettes Bauteil weggeworfen werden, nur weil der Speicherchip nicht funktioniert, obwohl der Logikchip an sich funktionsfähig ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren anzugeben, mit dem elektronische Bauteile mit Halbleiterchips in einem Stapel kostengünstig hergestellt werden können, und wobei die elektronischen Bauteile in Funktionstests verminderte Ausfallraten aufweisen.

25

Die Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils mit Halbleiterchips in einem Stapel geschaffen. Zunächst wird dazu ein Umverdrahtungssubstrat hergestellt, das Anschlussflächen für Flipchip-Verbindungen

FIN 406 P/200211221

2

in einem Mittenbereich aufweist. Außerdem weist das Umverdrahtungssubstrat in seinen Randbereichen Anschlussflächen für Bondverbindungen auf. Damit ist das Umverdrahtungssubstrat in der Lage, sowohl Halbleiterchips in Flipchip-Technik
5 als auch Halbleiterchips in Bondtechnik eines Stapels mit Außenkontakten des elektronischen Bauteils elektrisch zu verbinden. Auf dieses Umverdrahtungssubstrat, das in seinem Mittenbereich Anschlussflächen für Flipchip-Verbindungen aufweist, wird als nächstes ein als Halbleiterchip ausgebildeter
10 erster Elektronikbaustein in Flipchip-Technologie aufgebracht.

Parallel dazu wird wenigstens ein zweiter Elektronikbaustein hergestellt, der zusätzlich zu seinem Halbleiterchip eine Umverdrahtungsstruktur mit Außenkontaktflächen aufweist. Dieser
15 zweite Elektronikbaustein wird als oberer Baustein auf den ersten Elektronikbaustein so aufgebracht, dass die passiven Rückseiten des ersten und des zweiten Elektronikbausteins aufeinanderliegen. Anschließend werden Bondverbindungen zwischen den Außenkontaktflächen des zweiten oberen Elektronikbausteins und den Anschlussflächen in den Randbereichen des Umverdrahtungssubstrats hergestellt. Abschließend werden dann die gestapelten Elektronikbausteine unter Aufbringen einer Kunststoffgehäusemasse auf das Umverdrahtungssubstrat zu einem elektronischen Bauteil verpackt.
25

Dieses Verfahren hat den Vorteil, daß mit dem Aufbringen einer Umverdrahtungsstruktur auf die aktive Oberseite des Halbleiterchips des oberen Elektronikbausteins ein Zwischensubstrat geschaffen wird, das dem oberen Elektronikbaustein die
30 nötige Stabilität für die Handhabung in einem Testverfahren verleiht. Auf die Außenkontaktflächen der Umverdrahtungsstruktur können dazu zumindest vorübergehend Außenkontakte

FIN 406 P/200211221

3

aufgebracht werden, um die Funktionen des oberen Elektronikbausteins unabhängig von dem Stapel unter extremen Temperaturzyklen zu testen. Diese für vorgegebene Testsockel eventuell notwendigen Außenkontakte können vor dem Einbau des oberen Elektronikbausteins in den Stapel wieder entfernt werden, um die Außenkontaktflächen für ein Bonden beim Zusammenbau des elektronischen Bauteils zur Verfügung zu stellen.

Durch die erhöhte Stabilität des oberen Elektronikbausteins können die Bondverbindungen zwischen den randseitigen Außenkontakten der Umverdrahtungsstruktur des oberen Elektronikbausteins und den Anschlussflächen für Bondverbindungen in den Randbereichen des Umverdrahtungssubstrats nach dem Aufeinanderbringen der passiven Rückseiten der Elektronikbausteine unproblematisch und mit erhöhter Zuverlässigkeit hergestellt werden. Das spröde Material des Halbleiterchips des oberen Bausteins wird nämlich durch den Zwischenträger der Umverdrahtungsstruktur beim Bonden entlastet, so daß die Gefahr der Bildung von Mikrorissen in dem Halbleiterchip während des Bondens vermindert ist. Um eine Bondverbindung zu schaffen, weisen die Flächennormalen der Anschlussflächen für Bondverbindungen und die Flächennormalen der Außenkontaktflächen des oberen Elektronikbausteins in die gleiche Richtung.

Ein möglicher weiterer Vorteil des Verfahrens liegt darin, dass auch Bauteile mit größerer passiver Rückseite als die darunter angeordneten Halbleiterchips als zu bondende obere Elektronikbausteine eingesetzt werden können, weil die Stabilität der oberen Elektronikbausteine durch die Umverdrahtungsstruktur mit Zwischensubstrat im Bereich der zu bondenden Außenkontaktflächen erhöht ist und nicht auf dem Halbleiterchip, sondern auf dem Zwischensubstrat gebondet wird. Dieser Vorteil wirkt sich besonders aus, wenn als erster unterer

FIN 406 P/200211221

4

Elektronikbaustein ein Logikchip eingesetzt wird und als zweiter oberer Elektronikbaustein ein flächenmäßig größerer Speicherchip verwendet wird.

- 5 Vor einem Aufbringen des oberen Elektronikbausteins auf die passive Rückseite des Halbleiterchips des unteren Elektronikbausteins kann somit der obere Elektronikbaustein Temperaturen von - 50°C bis 150°C ausgesetzt werden, wenn seine Funktionsfähigkeit getestet wird. Dabei wird der Baustein elektrisch in Betrieb gesetzt. Dazu kann die Umverdrahtungsstruktur mit ihren Außenkontaktflächen an das Rastermaß entsprechender Testsockel angepaßt sein. Durch die oben erwähnte vorübergehende Aufbringung von Außenkontakten auf die Außenkontaktflächen der Umverdrahtungsstruktur kann darüber hinaus eine verbesserte Kontaktierung zu den Testsockeln geschaffen werden. Nach dem Entfernen der vorübergehend angebrachten Außenkontakte stehen die Außenkontaktflächen für ein Anbringen von Bondverbindungen bei dem Zusammenbau des elektronischen Bauteils wieder zur Verfügung.
- 20 Erfindungsgemäß kann während eines Funktionstests auf sämtliche Signalanschlüsse des oberen Elektronikbausteins zugegriffen werden. Dementsprechend ist ein aussagekräftigeres Testergebnis möglich, zumal nach dem Zusammenbau des elektronischen Bauteils ein Zugriff auf alle Signalanschlüsse des oberen Elektronikbausteins unabhängig von den übrigen Elektronikbausteinen des Stapels nicht mehr möglich ist. Wird ein derartiger Funktionstest für den oberen Elektronikbaustein vor dem Zusammenbau des elektronischen Bauteils durchgeführt, so steigt die Gesamtausbeute und es ergeben sich erhebliche Kostenvorteile. Es wird nämlich mindestens einer oder beide der Elektronikbausteine vorgetestet, wodurch sichergestellt werden kann, daß auch Elektronikbausteine mit potentiell ho-

FIN 406 P/200211221

5

her Ausfallwahrscheinlichkeit wie etwa Speicherchips nur dann eingesetzt werden, wenn diese wie vorstehend beschrieben eingehend getestet wurden. Durch ein Stapeln von Elektronikbausteinen übereinander wird zusätzlich Raum eingespart, die

5 Schaltungsdichte vergrößert, und die Kosten werden optimiert. Darüber hinaus werden die elektrischen Eigenschaften verbessert, da kurze Bondverbindungen realisiert werden, was mit einer Verminderung parasitärer Induktivitäten verbunden ist.

10 Die passiven Rückseiten der Elektronikbausteine können in vorteilhafter Weise aufeinander geklebt werden. Dazu können Leitkleber eingesetzt werden, beispielsweise wenn die Rückseiten der Elektronikbausteine auf gleichem Potential liegen sollen. Sind Potentialdifferenzen zwischen den Rückseiten der

15 Elektronikbausteine vorgesehen, so können isolierende Klebstoffe eingesetzt werden.

Die Bondverbindungen zwischen den Außenkontakten des oberen Elektronikbausteins und den Anschlussflächen im Randbereich

20 des Umverdrahtungssubstrats können mittels Thermokompressionsbonden hergestellt werden. Dabei wird auf einer der zu verbindenden Flächen ein Bondkopf gebildet, von dem aus der Bonddraht zunächst in Richtung der Flächennormale geführt wird, bevor er zu der zweiten Fläche hin gebogen werden kann

25 und dort unter Bildung eines Bondbogens mit der zweiten Fläche elektrisch verbunden wird. Während der Bondbogen auf der zweiten Fläche fast tangential zu der Fläche angebracht werden kann, benötigt der Bondkopf mit dem abgebogenen Bonddraht eine Mindesthöhe über der gebondeten Fläche. Deshalb ist es

30 vorteilhaft, wenn der Bondkopf zunächst auf der Anschlussfläche für die Bondverbindungen in dem Randbereich des Umverdrahtungssubstrats hergestellt wird, und erst danach der Bondbogen auf der Außenkontaktfäche der Umverdrahtungsstruk-

tur des oberen Elektronikbausteins gebildet wird. Dadurch wird auch die Bauteilhöhe des elektronischen Bauteils mit Halbleiterchips in einem Stapel minimiert.

- 5 In die Umverdrahtungsstruktur des oberen Elektronikbausteins kann ein zentraler Bondkanal eingebracht sein. Die zentralen Bondverbindungen dieses zentralen Bondkanals werden über Bondfinger und über Umverdrahtungsleitungen elektrisch leitend mit den Außenkontaktflächen verbunden. Die Außenkontakt-
- 10 flächen können auf Randbereiche des oberen Elektronikbausteins verteilt werden, wodurch das Bonden zu den Anschlussflächen in den Randbereichen des Umverdrahtungssubstrats erleichtert und kurze Bonddrähtlängen ermöglicht werden.
- 15 Die zentralen Bondverbindungen in dem Bondkanal weisen gegenüber den Bondverbindungen auf den Außenkontaktflächen geringe Abmessungen auf, so dass sie bereits durch den Bondkanal insofern ausreichend geschützt sind, dass der obere Elektronikbaustein mit offenem ungeschütztem Bondkanal einem Funktionstest vorsichtiger Handhabung ausgesetzt werden kann. Der
- 20 Bondkanal kann jedoch in vorteilhafter Weise unter Einbetten der zentralen Bondverbindungen des Bondkanals von einer Schutzumhüllung aus Kunststoff bedeckt werden, bevor der obere Elektronikbaustein einem Funktionstest ausgesetzt wird.
- 25 Dies hat den Vorteil, dass die Handhabung sowohl bei der Funktionsprüfung als auch bei dem späteren Zusammenbau erleichtert wird und eine Beschädigung der zentralen Bondverbindungen zuverlässig vermieden wird.
- 30 Als Umverdrahtungssubstrat kann eine beidseitig metallisierte Leiterplatte eingesetzt werden, deren Metallplattierungen auf ihrer Oberseite und auf ihrer Unterseite strukturiert werden. Die Struktur der Oberseite kann in einem Mittenbereich Kon-

taktanschlußflächen für Flipchip-Verbindungen aufweisen. In den Randbereichen der Oberseite können Anschlussflächen für Bondverbindungen geschaffen werden. Die strukturierte Metallplattierung auf der Unterseite der Leiterplatte kann Außenkontaktflächen aufweisen, die mit den Anschlussflächen über Durchkontakte und über Umverdrahtungsleitungen elektrisch verbunden werden können. Ein derartiges Umverdrahtungssubstrat auf der Basis einer beidseitig metallisierten und strukturierten Leiterplatte kann kostengünstig hergestellt werden und hat gegenüber Umverdrahtungssubstraten auf Keramikbasis einen erheblichen Preisvorteil.

Nach dem Aufbringen der zu stapelnden Elektronikbausteine auf ein derartig präpariertes Umverdrahtungssubstrat können die Elektronikbausteine mittels einem Transfermoldverfahren in ein gefülltes Epoxidharz eingebettet werden. Dieses Verpacken kann gleichzeitig für mehrere elektronische Bauteile durchgeführt werden, wenn das verwendete Umverdrahtungssubstrat entsprechend viele Bauteilpositionen aufweist, in denen Elektronikbausteine gestapelt und gebondet sind. Während beim Transfermoldverfahren die Bondverbindungen aufgrund des hohen Druckes und der Fließeigenschaften des gefüllten Epoxidharzes stark belastet werden, ist ein Verpacken der Elektronikbausteine in ein Kunststoffgehäuse mittels Dispensverfahren wesentlich schonender.

Abschließend können auf die Außenkontaktflächen des Umverdrahtungssubstrats Außenkontakte aufgebracht werden. Diese Außenkontakte können Lötballen aufweisen, wobei eine die Außenkontaktflächen umgebende Lötstopplackschicht ein Benetzen beispielsweise von Umverdrahtungsleitungen durch das Material der Außenkontakte verhindert.

FIN 406 P/200211221

8

Die Erfindung betrifft auch ein elektronisches Bauteil mit Halbleiterchips in einem Stapel, das ein Umverdrahtungssubstrat umfaßt. In einem Mittenbereich des Umverdrahtungssubstrats sind Anschlussflächen für Flipchip-Verbindungen vorgesehen. In seinen Randbereichen weist das Umverdrahtungssubstrat Anschlussflächen für Bondverbindungen auf. Kontaktbereiche eines als Halbleiterchip ausgebildeten ersten unteren Elektronikbausteins sind mit den Anschlussflächen in dem Mittenbereich des Umverdrahtungssubstrats verbunden. Ein zweiter oberer Elektronikbaustein weist einen Halbleiterchip mit einer Umverdrahtungsstruktur und mit Außenkontaktflächen auf. Der obere Elektronikbaustein ist derart auf dem unteren Elektronikbaustein angeordnet, dass die passiven Rückseiten der Elektronikbausteine aufeinanderliegen. Zur elektrischen Verbindung des oberen Elektronikbausteins mit dem Umverdrahtungssubstrat sind zwischen den Außenkontaktflächen des oberen Elektronikbausteins und den Anschlussflächen in den Randbereichen des Umverdrahtungssubstrats Bondverbindungen vorgesehen.

Der Stapel aus mindestens einem Halbleiterchip in Flipchip-Technologie und aus einem Elektronikbaustein mit einer Umverdrahtungsstruktur und mit Außenkontaktflächen ist von einem Bauteilgehäuse umgeben. Ein elektronisches Bauteil aus einer Kombination aus einem Halbleiterchip als ersten unteren Elektronikbaustein und aus einem weitgehend gehäusten zweiten oberen Elektronikbaustein hat den Vorteil, dass die Außenkontaktflächen des oberen Elektronikbausteins eingesetzt werden können, um vor einem Zusammenbau zu einem elektronischen Bauteil die Funktionsfähigkeit des weitgehend gehäusten oberen Elektronikbausteins unter extremen Temperaturbedingungen zu testen, so daß eine zuverlässige Aussage darüber getätigt werden kann, ob der Stapel wenigstens einen vollständig funk-

FIN 406 P/200211221

9

tionsfähigen oberen Elektronikbaustein aufweist. Durch das Stapeln wird der Platzbedarf vermindert und die Schaltdichte erhöht. Durch die Möglichkeit einer separaten Funktionsprüfung des oberen Elektronikbausteins ergibt sich eine Kostenoptimierung und eine zuverlässige Prognostizierbarkeit der endgültigen elektrischen Eigenschaften des elektronischen Bauteils.

Diese Vorteile wirken sich besonders aus, wenn der untere Elektronikbaustein ein Logikchip und der obere Elektronikbaustein ein Speicherchip mit Umverdrahtungsstruktur und mit Außenkontaktflächen ist. Derartige Speicherchips weisen eine relativ hohe Ausfallrate bei Funktionstests mit extremen Temperaturen zwischen -50°C und 150°C auf. Diese Ausfallrate kann für das elektronische Bauteil mit einem Stapel aus einem Logikchip und aus einem Speicherchip vermindert werden, wenn der Speicherchip bereits eine Umverdrahtungsstruktur mit Außenkontaktflächen aufweist, durch die ein unabhängiger vollständiger Funktionstest vor einem weiteren Stapelbau möglich wird.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Außenkontaktflächen des oberen Elektronikbausteins auf Grund der Verdrahtungsstruktur in die Randbereiche des oberen Elektronikbausteins gelegt werden können, sodass äußerst kurze Bondverbindungen von den Außenkontaktflächen zu den Anschlussflächen in den Randbereichen des Umverdrahtungssubstrats möglich werden. Durch die kurzen Bondverbindungen wird eine ausreichende Bonddrahtstabilität erreicht, sodass als Material für das Kunststoffgehäuse ein hochgefülltes Epoxidharz eingesetzt werden kann, ohne besondere Vorkehrungen für den Schutz der Bondverbindungen zu treffen.

Die Umverdrahtungsstruktur mit ihrem Zwischensubstrat und den Außenkontaktflächen auf dem oberen Elektronikbaustein vergrößert gleichzeitig die mechanische Stabilität dieses Elektronikbausteins, wodurch die gesamte Zuverlässigkeit des elektronischen Bauteils erhöht ist, zumal die Gefahr von Mikrorissbildungen in dem Halbleiterchip beim Bonden dadurch vermindert wird, daß nicht unmittelbar auf dem Halbleiterchip gebondet wird.

10 Das Umverdrahtungssubstrat weist eine beidseitig metallisierte und strukturierte Leiterplatte auf. Diese Leiterplatte verfügt über Durchkontakte als elektrische Verbindung zwischen den strukturierten Metallschichten auf der Ober- und auf der Unterseite der Leiterplatte. Die Unterseite der Leiterplatte weist Außenkontaktflächen für Außenkontakte auf. 15 Die Oberseite der Leiterplatte weist in ihrem Mittenbereich die Anschlussflächen für die Flipchip-Verbindungen und in ihren Randbereichen die Anschlussflächen für Bondverbindungen auf. Die Außenkontaktflächen auf der Unterseite der Leiterplatte sind über Durchkontakte und über Umverdrahtungsleitungen mit den Anschlussflächen auf der Oberseite elektrisch verbunden. Ein derartiges Umverdrahtungssubstrat auf der Basis einer Leiterplatte ist kostengünstig herstellbar verglichen mit Umverdrahtungsfolien oder Umverdrahtungssubstraten 20 auf der Basis von Keramiken. 25

Zwischen den aufeinanderliegenden passiven Rückseiten der Elektronikbausteine ist eine Klebstoffschicht angeordnet. Wenn die Klebstoffschicht einen Leitkleber aufweist, können 30 die Rückseiten der Elektronikbausteine auf gleichem Potential liegen. Eine Klebstoffschicht aus Isolationsklebstoff kann beispielsweise dann zwischen beiden Rückseiten der Elektronikbausteine vorgesehen werden, wenn eine Potentialdifferenz

zwischen beiden Elektronikbausteinen an den Rückseiten gewünscht ist.

Der obere Elektronikbaustein weist auf seiner aktiven Ober-
5 seite einen zentralen Bondkanal mit zentralen Bondverbindun-
gen auf. Diese zentralen Bondverbindungen sind über die auf
der aktiven Oberseite angeordnete Umverdrahtungsstruktur mit
den Außenkontaktflächen verbunden. Dieser Bondkanal kann eine
Schutzhülle für seine zentralen Bondverbindungen aufwei-
10 sen, wodurch sich eine Materialgrenze zwischen einer derarti-
gen Schutzhülle und dem Kunststoffgehäuse des elektroni-
schen Bauteils ausbildet. Ein derartiger Bondkanal mit zen-
tralen Bondverbindungen wird insbesondere für Speicherchips
eingesetzt, um die relativ große aktive Oberseite der Spei-
15 cherchips zu beiden Seiten des Bondkanals für das Anordnen
von Außenkontaktflächen zu nutzen.

Die Bondverbindungen zwischen den Außenkontaktflächen und den
Anschlussflächen der Außenbereiche des Umverdrahtungssub-
20 strats können einen Bonddraht aufweisen, der sich in einen
Bondkopf und in einen Bondbogen gliedert. Der Bondkopf kann
auf einer der Anschlussflächen des Umverdrahtungssubstrats
angeordnet sein, während der Bondbogen auf der entsprechenden
Außenkontaktfläche des oberen Elektronikbausteins angeordnet
25 ist. Diese Ausführung der Bondverbindungen hat den Vorteil,
dass für den Bondbogen eine geringere Höhe beansprucht wird,
als für den Bondkopf, so daß die Gesamthöhe des elektroni-
schen Bauteils minimiert werden kann.

30 Weiterhin ist vorgesehen, dass zwischen der aktiven Oberseite
des Halbleiterchips des unteren Elektronikbausteins bei den
Kontaktbereichen und der Oberseite des Umverdrahtungssub-
strats ein Zwischenraum ausgebildet ist. Dieser Zwischenraum

ist mit einem Unterfüllstoff aufgefüllt, der einen hochge-
füllten Kunststoff mit einem Füllgrad von 80 bis 95 Gew.%
aufweist. Dieser hohe Füllgrad des Unterfüllstoffes ermög-
licht eine weitgehende Anpassung des thermischen Ausdehnungs-
5 verhaltens des Unterfüllstoffes an das thermische Ausdehnungs-
verhalten des Halbleiterchips.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein Speicherchip bei-
spielsweise in einem BOC-Gehäuse (board on chip package) als
10 zweiter oberer Baustein in einem elektronischen Bauteil ein-
gesetzt werden kann, bevor er mit seiner freibleibenden Chi-
prückseite auf einen Logikchip in Flipchip-Technik geklebt
wird, in seinem Gehäuse bereits geburnt bzw. extremen Tempe-
raturen ausgesetzt und getestet werden kann. Durch Optimieren
15 des Bondprozesses beim Verbinden des oberen Speicherchips mit
dem Umverdrahtungssubstrat kann außerdem eine raumsparende
Stapelung eines Speicherchips auf einem Logikchip erreicht
werden.

20 Durch die auf dem Speicherchip angebrachte Umverdrahtungs-
struktur mit ihrem Zwischensubstrat entsteht bezüglich Design
und Routing bzw. Umverdrahtungsführung ein sehr flexibles Ge-
häusekonzept. Dieses Gehäuse des oberen Speicherchips er-
leichtert die Anpassung beim Verwenden von Speicherbausteinen
25 verschiedener Zulieferer oder bei Technologieänderungen, da
über die Umverdrahtungsstruktur Anpassungen vorgenommen wer-
den können, ohne dass Veränderungen des Umverdrahtungssub-
strats mit dem unteren Flipchip-Baustein vorgenommen werden
müssen. Somit ergibt sich ein kostengünstiger, flexibler und
30 anpassungsfähiger Aufbau zum Stapeln eines Elektronikbausteins
in Flipchip-Technologie mit einem Elektronikbaustein in Bond-
Technologie.

Die Erfindung wird nun anhand der beigefügten Figuren näher erläutert.

- 5 Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektronischen Bauteils gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung,
- 10 Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektronischen Bauteils einer zweiten Ausführungsform der Erfindung,
- 15 Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektronischen Bauteils einer dritten Ausführungsform der Erfindung,
- 20 Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektronischen Bauteils einer vierten Ausführungsform der Erfindung,
- 25 Figuren 5 bis 11 zeigen schematische Querschnitte von Zwischenprodukten bei der Herstellung des elektronischen Bauteils gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung,
- 30 Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Umverdrahtungssubstrats,
- Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Umverdrahtungssubstrats mit einem aufgebrachtten ersten Elektronikbaustein,

- Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt eines zweiten Elektronikbausteins mit einem ungeschützten Bondkanal,
- 5 Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt des zweiten Elektronikbausteins aus Fig.7 mit einem geschützten Bondkanal,
- 10 Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen Stapel mit dem erstem Elektronikbaustein und mit dem zweitem Elektronikbaustein auf dem Umverdrahtungssubstrat aus Figur 5,
- 15 Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen Stapel aus Figur 9 nach Aufbringen von Bondverbindungen,
- 20 Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil nach Verpacken des Stapels aus Figur 10 in einem Bauteilgehäuse,
- 25 Figur 12 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil nach Aufbringen von Außenkontakten auf das Umverdrahtungssubstrat des elektronischen Bauteils.
- 30 Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektronischen Bauteils 1 einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Die Basis dieses elektronischen Bauteils 1 bildet ein Umverdrahtungssubstrat 5 mit einer Oberseite 36 und mit einer Unterseite 40, die gleichzeitig die Unterseite des elektronischen Bauteils 1 bildet. Auf der Unterseite 40 sind Außenkontakte 30 in Form von Kontaktbällen angeordnet, die auf Außen-

FIN 406 P/200211221

15

kontaktflächen 27 des Umverdrahtungssubstrats 5 gelötet sind. Diese Außenkontaktflächen 27 des Umverdrahtungssubstrats 5 sind über Durchkontakte 26 und über Umverdrahtungsleitungen 25 des Umverdrahtungssubstrats 5 mit Anschlussflächen 6 und 60 auf der Oberseite 36 des Umverdrahtungssubstrats 5 verbunden. Das Umverdrahtungssubstrat 5 weist in dieser ersten Ausführungsform der Erfindung eine Leiterplatte 23 als Trägermaterial auf.

- 10 In einem Mittenbereich 7 sind auf der Oberseite 36 des Umverdrahtungssubstrats 5 Anschlussflächen 6 zum Verbinden mit Flipchip-Kontakten angeordnet. In den Randbereichen 10 sind auf der Oberseite 36 des Umverdrahtungssubstrats 5 Anschlussflächen 60 für Bondverbindungen angeordnet. Auf den An-
- 15 schlussflächen 6 des Mittenbereichs 7 ist wenigstens ein Logikchip 28 mit seinen Kontaktbereichen 24 über die Flipchip-Verbindungen 8 als ein erster unterer Elektronikbaustein 9 aufgebracht. Auf der passiven Rückseite 15 dieses ersten Elektronikbausteins 9 ist eine Klebeschicht 31 angeordnet,
- 20 mit der ein zweiter oberer Elektronikbaustein 12 auf dem ersten unteren Elektronikbaustein 9 angeordnet ist.

- Bei dem zweiten Elektronikbaustein 12 handelt es sich um einen Speicherchip 39, der einen zentralen Bondkanal 19 auf
- 25 seiner aktiven Oberseite 32 mit zentralen Bondverbindungen 111 aufweist. Diese zentralen Bondverbindungen 111 des Bondkanals 19 sind über Bondfinger 20 der Umverdrahtungsstruktur 13 mit Außenkontaktflächen 14 des oberen Elektronikbausteins 12 verbunden. Die Umverdrahtungsstruktur 13 weist ein Zwischensubstrat 41 auf, auf dessen Randbereichen die Außenkontaktflächen 14 angeordnet sind. Die Außenkontaktflächen 14
- 30 sind über Bondköpfe 33 von Bonddrähten 18 mit den Anschluss-

FIN 406 P/200211221

16

flächen 60 in dem Randbereich 10 des Umverdrahtungssubstrats 5 unter Ausbildung eines Bondbogens 34 verbunden.

Ein Bauteilgehäuse 29 umgibt diesen Stapel 4 aus mindestens
5 einem unteren Logikchip 28 und einem oberen Speicherchips 39
sowie die Bondverbindungen 18 zwischen dem oberen Speicher-
chip 39 und dem Umverdrahtungssubstrat 5. Ein Unterfüll-
stoff 37, der einen hochgefüllten Kunststoff mit einem Füll-
grad zwischen 80 und 95 Gew.% aufweist, füllt einen Zwischen-
raum zwischen der aktiven Oberseite 35 des Logikchips 28 und
10 der Oberseite 36 des Umverdrahtungssubstrats 5 und bettet die
Kontaktbereiche 24 des Logikchips 28 ein. Der hohe Füllgrad
sorgt für eine weitgehende Anpassung des thermischen Ausdeh-
nungsverhaltens des Unterfüllstoffes 37 an das thermische
15 Ausdehnungsverhalten des Halbleitermaterials des Logikchips
28. Eine Schutzumhüllung 22 deckt den Bondkanal 19 ab und
schützt die zentralen Bondverbindungen 111 des Speicherchips
39. Zwischen der Schutzumhüllung 22 und der umgebenden Kunst-
stoffgehäusemasse 17 des Bauteilgehäuses 29 bildet sich eine
20 Materialgrenze 38 aus.

Dieses elektronische Bauteil 1 weist somit einen Stapel 4 aus
einem Halbleiterchip 2 in Flipchip-Technologie und aus einem
nahezu vollständig gehäusten Elektronikbaustein 12 auf. Die
25 Funktionsfähigkeit dieses Elektronikbausteins 12 ist vor sei-
nem Einbau in das elektronische Bauteil 1 unter extremen Tem-
peraturen zwischen -50 und 150 °C getestet worden. Dieser
Funktionsfähigkeitstest kann durchgeführt werden, indem ent-
weder die Außenkontaktflächen 14 des oberen Elektronikbau-
steins 12 mit einem entsprechenden Prüfsockel verbunden wer-
30 den oder indem Außenkontakte vorübergehend auf die Außenkon-
taktflächen 14 aufgebracht werden, die nach dem Test und vor

FIN 406 P/200211221

17

dem Einbau in das elektronische Bauteil 1 wieder entfernt werden.

5 In einem hier nicht gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Unterfüllstoff 37 weggelassen, wobei der Spalt zwischen der aktiven Oberseite 35 und der Oberseite 36 mit der Kunststoffgehäusemasse 17 aufgefüllt sind.

10 Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektronischen Bauteils 1 gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in Figur 1 werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

15 Ein Unterschied zwischen dem elektronischen Bauteil 1 aus Figur 1 zu dem elektronischen Bauteil 1 der zweiten Ausführungsform der Erfindung besteht darin, dass die Bonddrähte 18 der Bondverbindungen 11 mit ihren Bauteilhöhe beanspruchenden Bondköpfen 33 auf den Anschlussflächen 60 in den Randberei-
20 chen 10 des Umverdrahtungssubstrats 5 angeordnet sind. Der relativ flache Bondbogen 34 einer derartigen Bondverbindung 11 ist auf den Außenkontakten 14 des oberen Elektronikbausteins 12 angeordnet. Dadurch ist es möglich, die Bauteilhöhe des elektronischen Bauteils 1 durch die Schutzumhüllung 22 des Bondkanals 19 zu begrenzen. Das elektronische
25 Bauteil 1 weist somit eine geringere Höhe auf als das elektronische Bauteil 1 aus Figur 1. Die Materialgrenze 38 zwischen der Kunststoffgehäusemasse 17 und dem Kunststoff der Schutzumhüllung 22 des Bondkanals 19 ist somit auf die Rand-
30 seiten der Schutzumhüllung 22 begrenzt.

Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektronischen Bauteils 1 gemäß einer dritten Ausführungsform der

Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

- 5 Der Aufbau des Stapels aus den Elektronikbausteinen 9 und 12 ist bei der dritten Ausführungsform der Erfindung der gleiche wie bei der ersten Ausführungsform der Erfindung aus Figur 1. Jedoch wird hier der Bondkanal 19 des oberen Elektronikbausteins 12 von der Kunststoffgehäusemasse 17 bedeckt, sodass
10 sich keine Materialgrenze 38 gemäß Figur 1 ausbildet. In diesem elektronischen Bauteil 1 wird beim Zusammenbau der Verfahrensschritt zum Einbetten der zentralen Bondverbindungen 111 des Bondkanals 19 in eine Schutzumhüllung 22 eingespart. Dennoch ist der obere Elektronikbaustein 12 vor dem
15 Einbau in ein derartiges elektronisches Bauteil 1 auf Funktionsfähigkeit testbar. Er weist die für den Funktionstest notwendigen Außenkontaktflächen 14 auf.

- Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elektronischen Bauteils 1 einer vierten Ausführungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

- 25 Der innere Aufbau dieses elektronischen Bauteils 1 der vierten Ausführungsform der Erfindung entspricht dem Aufbau des elektronischen Bauteils 1 aus Figur 2. Jedoch ist die Schutzumhüllung 22 des Bondkanals 19 für den oberen Elektronikbaustein 12 aus Gründen der Kostenersparnis weggelassen.
30 Damit wird ein elektronisches Bauteil 1 mit einer minimalen Bauteilhöhe kostengünstig realisiert.

Die Figuren 5 bis 12 zeigen schematische Querschnitte von Zwischenprodukten bei der Herstellung eines elektronischen Bauteils 1 gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden 5 Figuren werden in den Figuren 5 bis 12 mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erörtert.

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Umverdrahtungssubstrats 5. Dieses Umverdrahtungssubstrat 5 ist aus einer beidseitig metallisierten und beidseitig strukturierten Leiterplatte 23 gefertigt. Die Metallstruktur der Oberseite 36 der Leiterplatte 23 ist mit der Metallstruktur auf der Unterseite 40 der Leiterplatte 23 über Durchkontakte 26 verbunden. Die Unterseite 40 der Leiterplatte 23 weist Außenkontaktflächen 27 auf, die in 3 Ringen auf der Unterseite 40 der Leiterplatte 23 angeordnet sind. Auf der Oberseite 36 der Leiterplatte 23 sind Umverdrahtungsleitungen 21 angeordnet, die mit den Durchkontakten 26 elektrisch verbunden sind. Außerdem verbinden die Umverdrahtungsleitungen 21 die Durchkontakte 26 und damit die Außenkontaktflächen 27 mit Anschlussflächen 6 für die Flipchip-Verbindungen 8 in einem Mittenbereich 7 der Leiterplatte 23 und/oder mit Anschlussflächen 60 für die Bondverbindungen 18 in Randbereichen 10 der Leiterplatte 23.

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Umverdrahtungssubstrats 5 mit einem aufgebrachten ersten Elektronikbaustein 9. Dieser Elektronikbaustein 9 ist über Flipchip-Verbindungen 8 mit den Anschlussflächen 6 des Mittenbereichs 7 des Umverdrahtungssubstrats 5 verbunden. Der Zwischenraum zwischen der aktiven Oberseite 35 des ersten unteren Elektronikbausteins 9 und der Oberseite 36 des Umverdrahtungssubstrats 5 ist mit einem Unterfüllstoff 37 aufgefüllt.

FIN 406 P/200211221

20

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Elektronikbausteins 12 mit einem ungeschützten Bondkanal 19. Dieser zweite Elektronikbaustein 12 weist zusätzlich zu einem Halbleiterchip 3, der hier ein Speicherchip 39 ist, eine Umverdrahtungsstruktur 13 mit einem Zwischensubstrat 41 auf. Darüber hinaus weist dieser zweite Elektronikbaustein 12 einen Bondkanal 19 mit zentralen Bondverbindungen 111 auf, die über die Umverdrahtungsstruktur 13 mit Außenkontaktflächen 14 des Elektronikbausteins 12 verbunden sind.

Ein derartig vorbereiteter Elektronikbaustein 12 wird vor dem Einbau in ein elektronisches Bauteil extremen Temperaturen zwischen -50 und 150 °C ausgesetzt, während seine Funktionsfähigkeit geprüft wird. Dieser Funktionstest erfolgt auch, ohne daß die zentralen Bondverbindungen 111 in dem Bondkanal 19 bereits durch eine Schutzumhüllung geschützt sind.

Figur 8 zeigt einen schematischen Querschnitt des zweiten Elektronikbausteins 12 aus Figur 7 mit einem geschützten Bondkanal 19. Die Handhabung des zweiten Elektronikbausteins 12 ist aufgrund des geschützten Bondkanals 19 gegenüber der Handhabung eines Elektronikbausteins 12 mit einem ungeschützten Bondkanal 19, wie ihn Figur 7 zeigt, erleichtert und sicherer. Die empfindlichen zentralen Bondverbindungen 111 sind nämlich in der Schutzumhüllung 22 eingebettet und vor mechanischer Beschädigung bei der Handhabung geschützt.

Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen Stapel 4 eines ersten und zweiten Elektronikbausteins 9 bzw. 12 auf dem Umverdrahtungssubstrat 5 aus Figur 5. Dazu wird der in Figur 7 oder der in Figur 8 gezeigte vollständig funktionsgetestete zweite Elektronikbaustein 12 mit seiner passi-

ven Rückseite 16 mittels einer Klebstoffschicht 31 auf die passive Rückseite 15 des Elektronikbausteins 9 geklebt.

Figur 10 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen Stapel 4 aus Figur 9 nach dem Aufbringen von Bondverbindungen 11. Diese Bondverbindungen 11 sind auf die Außenkontaktflächen 14 der Umverdrahtungsstruktur 13 des oberen Elektronikbausteins 12 aufgebracht. Dazu wird zunächst ein Bondkopf 33 auf den Außenkontaktflächen 14 gebondet und der Bonddraht 18 nach unten zu den Anschlussflächen 60 des Umverdrahtungssubstrats 5 geführt. Unter Bilden eines Bondbogens 34 werden dann die Bonddrähte 18 mit den Anschlussflächen 60 verbunden.

Figur 11 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil 1 nach einem Verpacken des Stapels 4 aus Figur 10 in einem Bauteilgehäuse 29. Dabei bildet das Umverdrahtungssubstrat 5 mit seiner Unterseite 40 gleichzeitig die Unterseite des elektronischen Bauteils 1. Außerdem bildet sich eine Materialgrenze 38 zwischen dem Material der Schutzumhüllung 22 des Bondkanals 19 und der Kunststoffgehäusemasse 17 aus.

Figur 12 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein elektronisches Bauteil 1 nach Aufbringen von Außenkontakten 30 auf das Umverdrahtungssubstrat 5. Diese Außenkontakte 30 sind hier als Kontaktbälle ausgebildet und in 3 Ringen angeordnet. Dazu werden lötbare Kontaktbälle auf die Außenkontaktflächen 27 auf der Unterseite 40 der Umverdrahtungsstruktur 5 aufgelötet.

Bezugszeichenliste

	1	elektronisches Bauteil
	2	unterer Halbleiterchip
5	3	oberer Halbleiterchip
	4	Stapel
	5	Umverdrahtungssubstrat
	6	Anschlussflächen für Flipchip-Verbindungen
	7	Mittenbereich des Umverdrahtungssubstrats
10	8	Flipchip-Verbindungen
	9	unterer Elektronikbaustein
	10	Randbereich des Umverdrahtungssubstrats
	11	Bondverbindung
	12	oberer Elektronikbaustein
15	13.	Umverdrahtungsstruktur des oberen Elektronik- bausteins
	14	Außenkontaktflächen des oberen Elektronikbausteins
	15	passive Rückseite des unteren Elektronikbausteins
	16	passive Rückseite des oberen Elektronikbausteins
20	17	Kunststoffgehäusemasse
	18	Bonddrähte
	19	Bondkanal
	20	Bondfinger
	21	Umverdrahtungsleitungen der Umverdrahtungsstruktur
25	22	Schutzhülle
	23	beidseitig metallisierte Leiterplatte
	24	Kontaktbereiche
	25	Umverdrahtungsleitungen des Umverdrahtungssubstrats
	26	Durchkontakte
30	27	Außenkontaktflächen des Umverdrahtungssubstrats
	28	Logikchip
	29	Bauteilgehäuse
	30	Außenkontakte

FIN 406 P/200211221

2

	31	Klebeschicht
	32	aktive Oberseite des oberen Elektronikbausteins
	33	Bondkopf
	34	Bondbogen
5	35	aktive Oberseite des unteren Elektronikbausteins
	36	Oberseite des Umverdrahtungssubstrats
	37	Unterfüllstoff
	38.	Materialgrenze
	39	Speicherchip
10	40	Unterseite des Umverdrahtungssubstrats
	41	Zwischensubstrat
	60	Anschlussflächen für Bondverbindungen
	111	zentrale Bondverbindungen

15

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils (1) mit Halbleiterchips (2, 3) in einem Stapel (4), wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte aufweist:
- 5
- a) Bereitstellen eines Umverdrahtungssubstrats (5) mit Anschlussflächen (6) in einem Mittenbereich (7) für Flipchip-Verbindungen (8) eines unteren Elektronikbausteins (9) und mit Anschlussflächen (60) in Randbereichen (10) des Umverdrahtungssubstrats (5) für Bondverbindungen (11) zu einem oberen Elektronikbaustein (12),
- 10
- b) Aufbringen des als Halbleiterchip (2) ausgebildeten ersten unteren Elektronikbausteins (9) in Flipchip-Technologie in dem Mittenbereich (7) des Umverdrahtungssubstrats (5),
- 15
- c) Herstellen wenigstens eines zweiten oberen Elektronikbausteins (12), der einen Halbleiterchip (3) und eine Umverdrahtungsstruktur (13) mit Außenkontaktflächen (14) aufweist,
- 20
- d) Aufbringen des oberen Elektronikbausteins (12) auf den unteren Elektronikbaustein (9), so dass die passiven Rückseiten (10, 16) des unteren und des oberen Elektronikbausteins (9, 12) aufeinanderliegen,
- 25
- e) Herstellen von Bondverbindungen (11) zwischen den Außenkontaktflächen (14) des oberen Elektronikbausteins (12) und den Anschlussflächen (60) in den Randbereichen (10) des Umverdrahtungssubstrats (5),
- 30
- g) Verpacken der Elektronikbausteine (9, 12) unter Aufbringen einer Kunststoffgehäusemasse (17) auf das Umverdrahtungssubstrat (5).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der obere Elektronikbaustein (12) vor seinem Aufbringen
5 auf die passive Rückseite (15) des Halbleiterchips (2)
des unteren Elektronikbausteins (9) Prüfungen bei extre-
men Temperaturbedingungen, insbesondere von -50°C bis
150°C ausgesetzt wird.
- 10 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein Logikchip (28) als erster unterer Elek-
tronikbaustein (9) und wenigstens ein Speicherchip (39)
und mit Außenkontaktf lächen (14) als zweiter oberer
15 Elektronikbaustein (12) eingesetzt werden.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der obere Elektronikbaustein (12) auf die passive Rück-
20 seite (15) des unteren Elektronikbausteins (9) geklebt
wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
25 die Bondverbindungen (11) zwischen den Außenkontak-
ten (14) des oberen Elektronikbausteins (12) und den An-
schlussflächen (60) des Umverdrahtungssubstrats (5) mit-
tels Drahtbonden hergestellt werden.
- 30 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Verbinden der Anschlussflächen (60) in den Randbe-
reichen (10) des Umverdrahtungssubstrats (5) mit den Au-

Benkontaktflächen (14) des oberen Elektronikbausteins (12) Bonddrähte (18) zunächst auf den Anschlussflächen (60) und anschließend auf den Außenkontaktflächen (14) gebondet werden.

5

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in die Umverdrahtungsstruktur (13) des oberen Elektronikbausteins (12) ein zentraler Bondkanal (19) eingebracht wird, dessen Bondverbindungen (111) über Bondfinger (20) und über Umverdrahtungsleitungen (21) mit den Außenkontaktflächen (14) elektrisch leitend verbunden werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Bondkanal (19) unter Einbetten der Bondverbindungen (111) von einer Schutzumhüllung (22) aus Kunststoff bedeckt wird.

20

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Herstellung eines Umverdrahtungssubstrats (5) eine erste Metallplattierung einer beidseitig metallisierten Leiterplatte (23) mit Anschlussflächen (6) für Flipchip-Verbindungen in einem Mittenbereich (7), mit Anschlussflächen (60) für Bondverbindungen (11) in Randbereichen (10) und mit Umverdrahtungsleitungen (25) zu Durchkontakten (26) strukturiert wird, wobei die Durchkontakte (26) mit Außenkontaktflächen (27) einer strukturierten zweiten Metallplattierung der Leiterplatte (23) elektrisch verbunden werden.

30

FIN 406 P/200211221

25

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Verpacken der Elektronikbausteine ein gefülltes
Epoxidharz mittels Transfermoldverfahren auf das Umver-
drahtungssubstrat aufgebracht wird.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
zum Verpacken der Elektronikbausteine (9, 12) eine
Kunststoffgehäusemasse mittels Dispensverfahren auf das
Umverdrahtungssubstrat (5) aufgebracht wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
Außenkontakte (30) auf die Außenkontaktflächen (27) des
Umverdrahtungssubstrats (5) aufgebracht werden.
13. Elektronisches Bauteil mit Halbleiterchips in einem Sta-
pel, wobei das elektronische Bauteil (1) folgende Merk-
male aufweist:
- ein Umverdrahtungssubstrat (5) mit Anschlussflä-
chen (6) für Flipchip-Verbindungen (8) in einem
Mittenbereich (7) und mit Anschlussflächen (60) für
Bondverbindungen (11) in Randbereichen (10) des Um-
verdrahtungssubstrats (5),
 - wenigstens ein als Halbleiterchip (2) ausgebildeter
erster unterer Elektronikbaustein (9), der Kontakt-
bereiche (24) aufweist, die in Flipchip-Technologie
mit den Anschlussflächen (6) in dem Mittenbe-
reich (7) des Umverdrahtungssubstrats (5) elek-
trisch verbunden sind,
 - wenigstens ein zweiter oberer Elektronikbau-
stein (12), der einen Halbleiterchip (3) und eine

- Umverdrahtungsstruktur (13) mit Außenkontaktflächen (14) auf dem Halbleiterchip (3) aufweist, wobei der obere Elektronikbaustein (12) derart auf dem unteren Elektronikbaustein (9) angeordnet ist, dass die passiven Rückseiten (15, 16) der Elektronikbausteine (9, 12) aufeinanderliegen,
- Bondverbindungen (11) zwischen den Außenkontaktflächen (14) des oberen Elektronikbausteins (12) und den Anschlussflächen (60) in den Randbereichen (10) des Umverdrahtungssubstrats (5),
- einem Bauteilgehäuse (29), daß die Elektronikbausteine (9, 12) umgibt.
14. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzumhüllung (22) zu dem Material des Bauteilgehäuses (29) eine Materialgrenze (38) aufweist.
15. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 13 oder Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der untere Elektronikbaustein (9) als Logikchip (28) ausgebildet ist und dass der obere Elektronikbaustein (12) als Speicherchip (39) mit Umverdrahtungsstruktur (5) und mit Außenkontaktflächen (14) ausgebildet ist.
16. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Umverdrahtungssubstrat (5) eine beidseitig metallisierte und strukturierte Leiterplatte (23) mit Durchkontakten (26) als elektrische Verbindung zwischen den

5 strukturierten Metallschichten auf der Oberseite und auf
der Unterseite der Leiterplatte (23) aufweist, wobei die
Unterseite der Leiterplatte Außenkontaktflächen (27) mit
Außenkontakten (30) aufweist und wobei die Oberseite der
10 Leiterplatte die Anschlussflächen (6) für Flipchip-Ver-
bindungen (8) in einem Mittenbereich (7), die Anschluss-
flächen (60) für Bondverbindungen (11) in Randberei-
chen (10), sowie Umverdrahtungsleitungen (25) zwischen
den Anschlussflächen (6, 60) und den Durchkontakten (26)
15 aufweist.

17. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprüche 13 bis
16,
dadurch gekennzeichnet, dass
15 eine Klebstoffschicht (31) zwischen den passiven Rück-
seiten (15, 16) der Elektronikbausteine (9, 12) angeord-
net ist.

18. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprüche 13 bis
20 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
der obere Elektronikbaustein (12) eine aktive Obersei-
te (16) mit einem zentralen Bondkanal (19) mit Bondver-
bindungen (111) aufweist, wobei die Bondverbindungen
25 (111) über die auf der aktiven Oberseite (32) angeordne-
te Umverdrahtungsstruktur (13) mit den Außenkontaktflä-
chen (14) verbunden sind.

19. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 18,
30 dadurch gekennzeichnet, dass
der Bondkanal (19) mit seinen Bondverbindungen (111) ei-
ne Schutzumhüllung (22) aufweist.

20. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprüche 13
bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Flächennormale der Anschlussflächen (60) des Umver-
drahtungssubstrats (5) und die Flächennormale der Außen-
kontaktflächen (14) der Umverdrahtungsstruktur (13) in
die gleiche Richtung weisen.
21. Elektronisches Bauteil nach einem der Ansprüche 13
bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bondverbindungen (11) einen Bonddraht (18) aufwei-
sen, der einen Bondbogen (34) ausbildet, der von einer
der Anschlussflächen (60) des Umverdrahtungssubstrats
(5) zu der entsprechenden Außenkontaktfläche (14) des
oberen Elektronikbausteins (12) verläuft.

Zusammenfassung

Elektronisches Bauteil mit Halbleiterchips in einem Stapel und Verfahren zur Herstellung desselben.

5

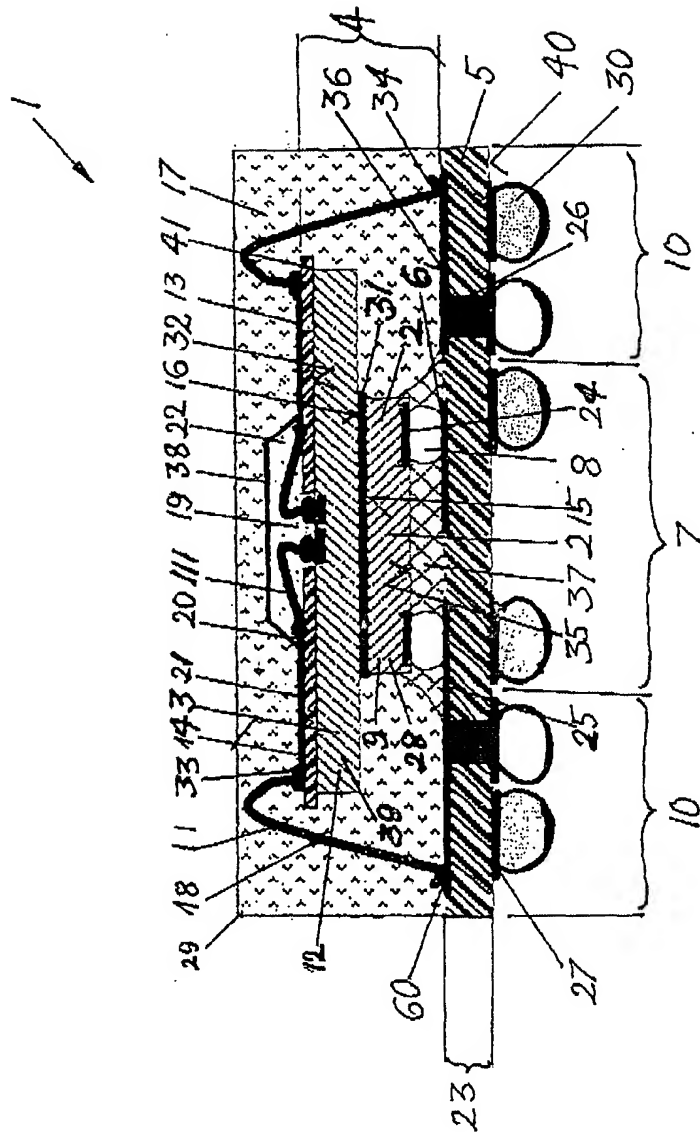
Die Erfindung betrifft sowohl ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils (1) mit Halbleiterchips (2, 3) in einem Stapel (4) und als auch ein derartiges elektronisches Bauteil (1). Der Stapel (4) weist wenigstens einen ersten unteren Elektronikbaustein (9) auf, der über Flipchip-Verbindungen (8) mit einem Mittenbereich (7) eines Umverdrahtungssubstrats (5) verbunden ist. Der Stapel (4) weist weiterhin wenigstens einen zweiten oberen Elektronikbaustein (12) mit Außenkontaktflächen (14) auf, die über Bondverbindungen (11) mit Außenbereichen (10) des Umverdrahtungssubstrats (5) verbunden sind.

10
15

[Figur 1]

20

FIG. 1



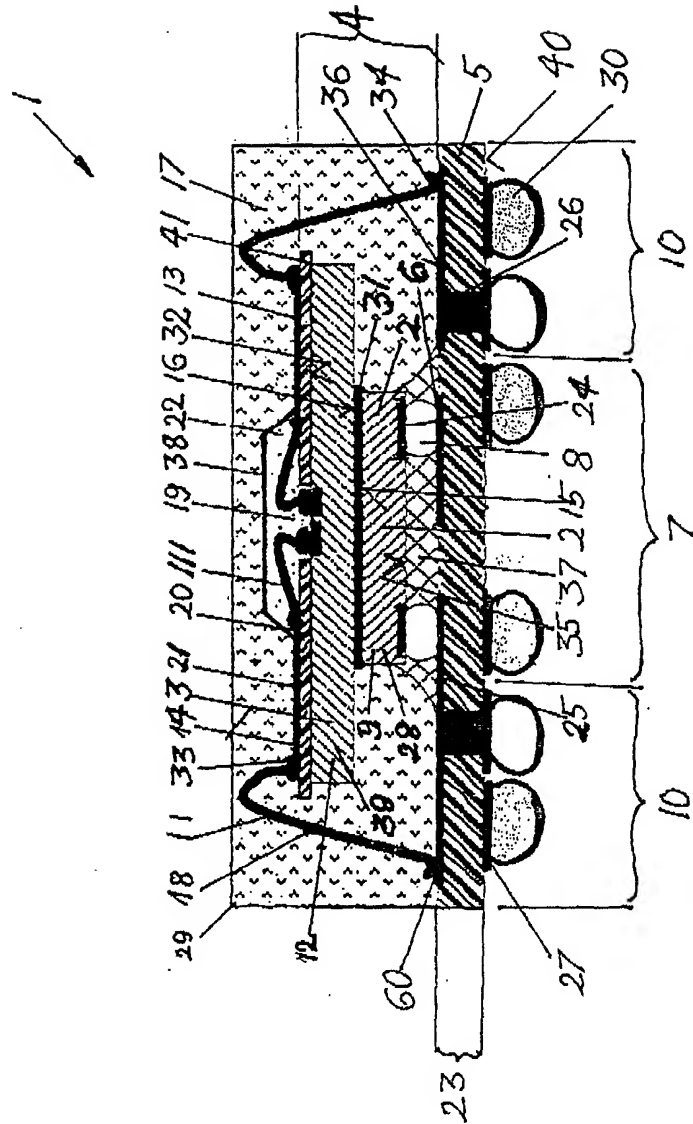


FIG 1

FIG 5

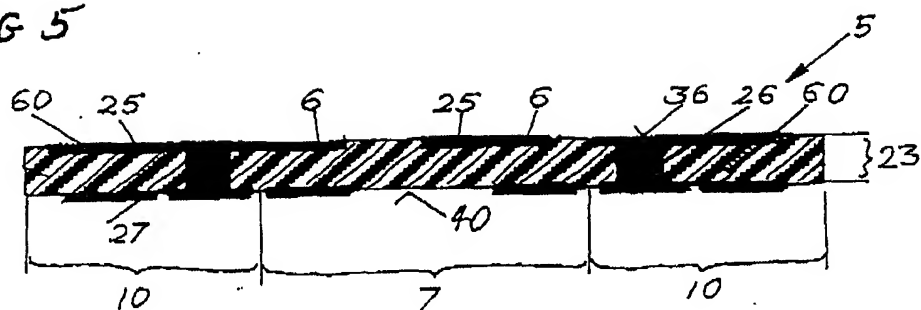


FIG 6

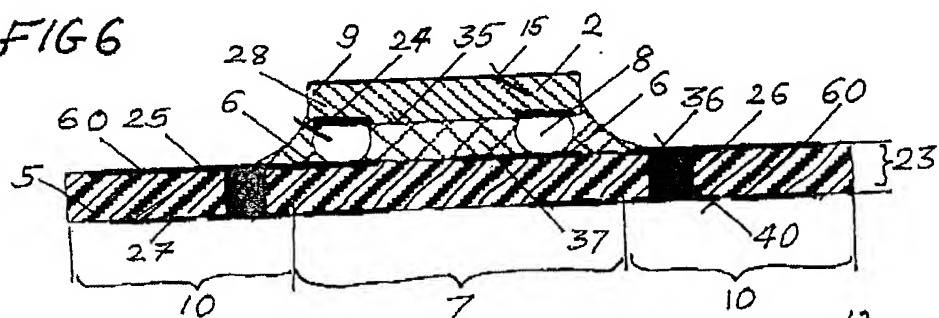


FIG 7

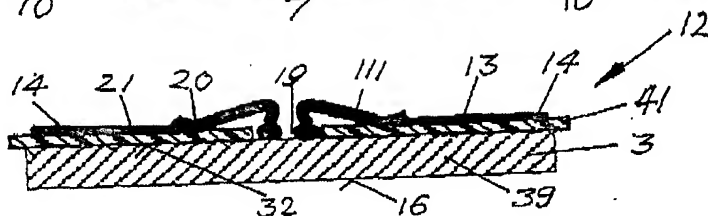


FIG 8

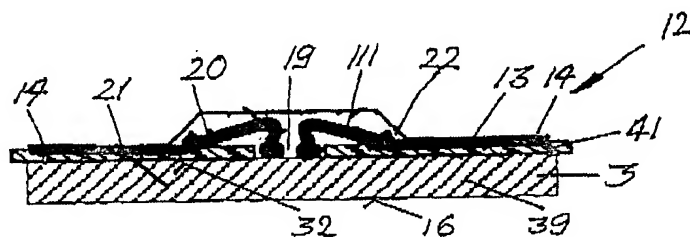


FIG 9

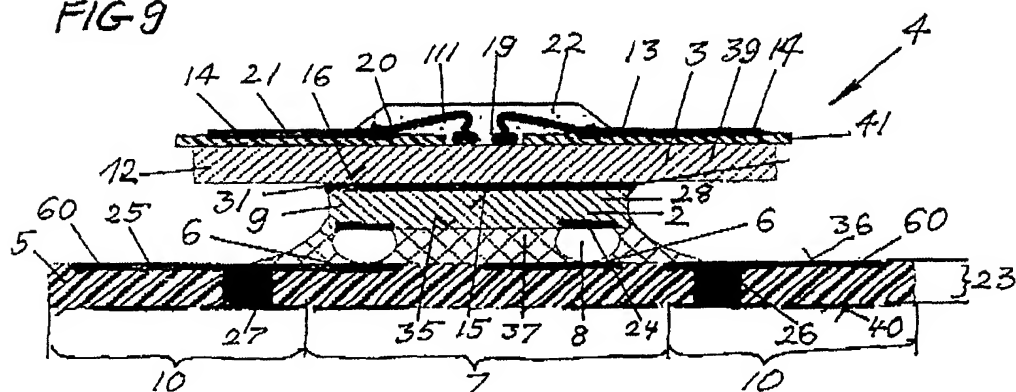


FIG 10

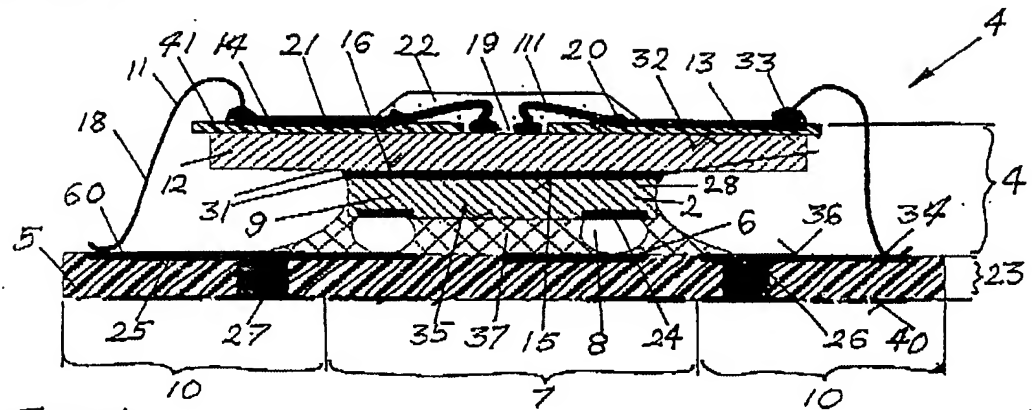


FIG 11

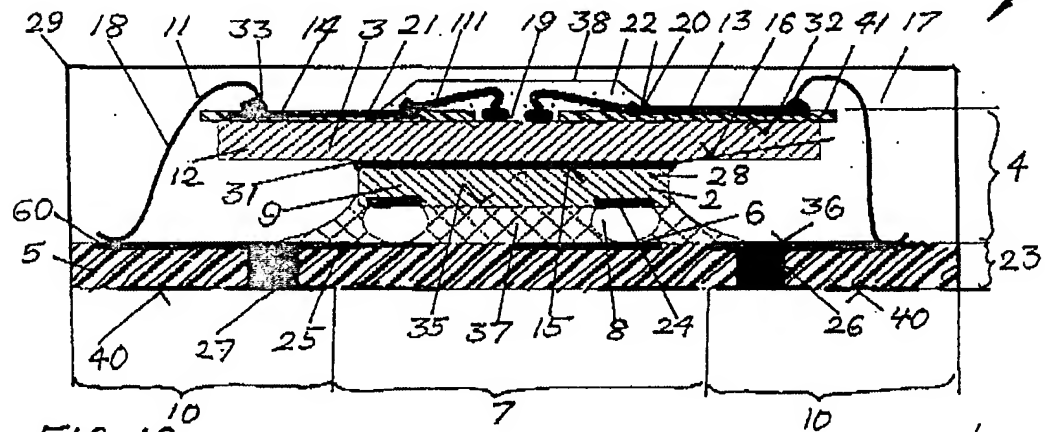
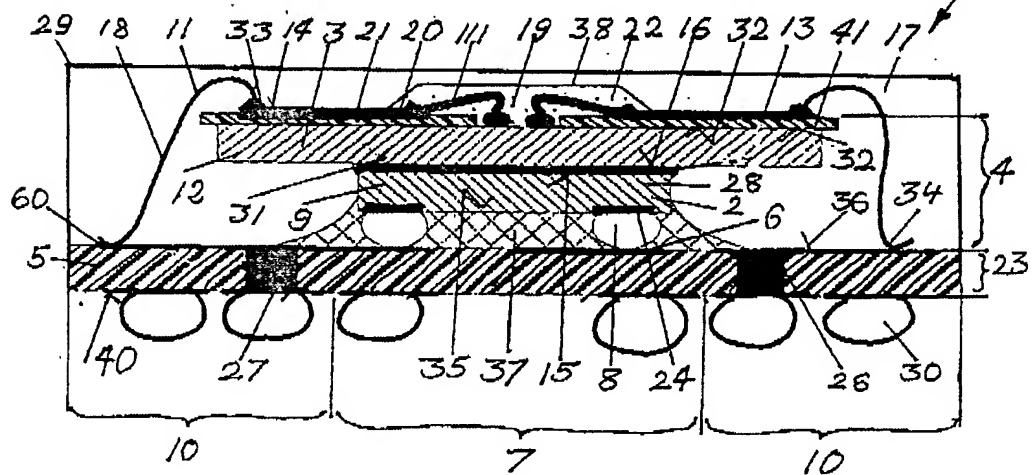


FIG 12



GESAMT SEITEN 39